SMD-1G48

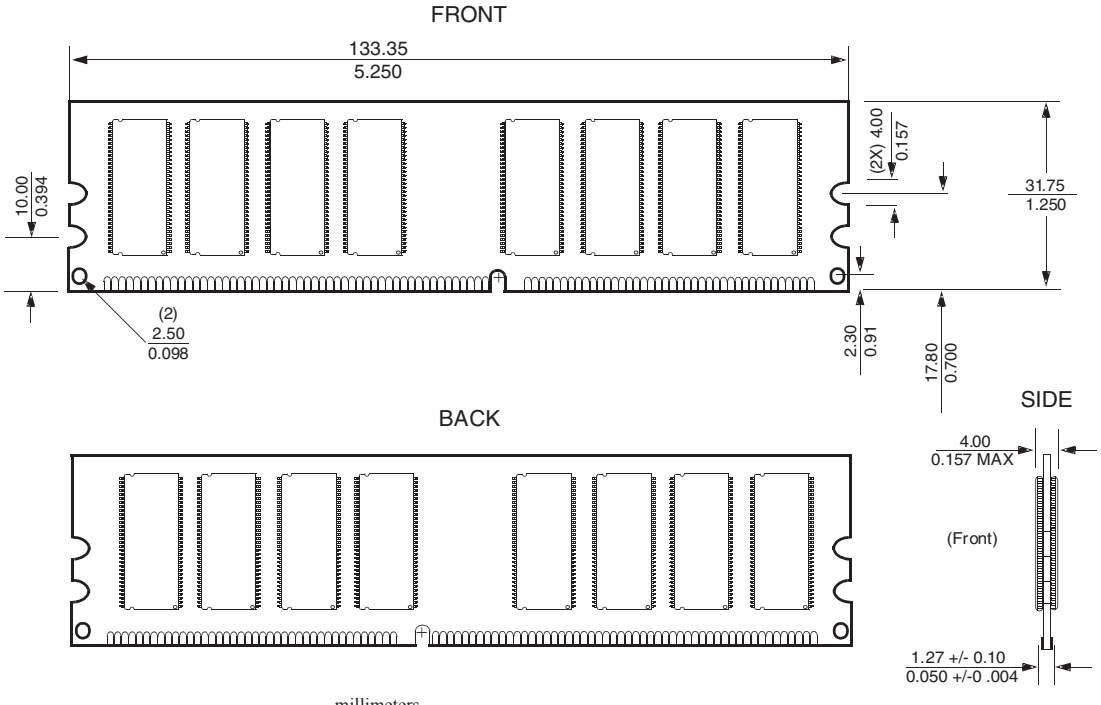
DESCRIPTION

ＳＭＤ－１Ｇ４８は、５１２MビットＤＤＲ・ＤＲＡＭ（64M x 8bit）を１６個搭載した１２８Ｍｘ６４ビットＤＤＲ・ＤＲＡＭモジュールです。

FEATURES

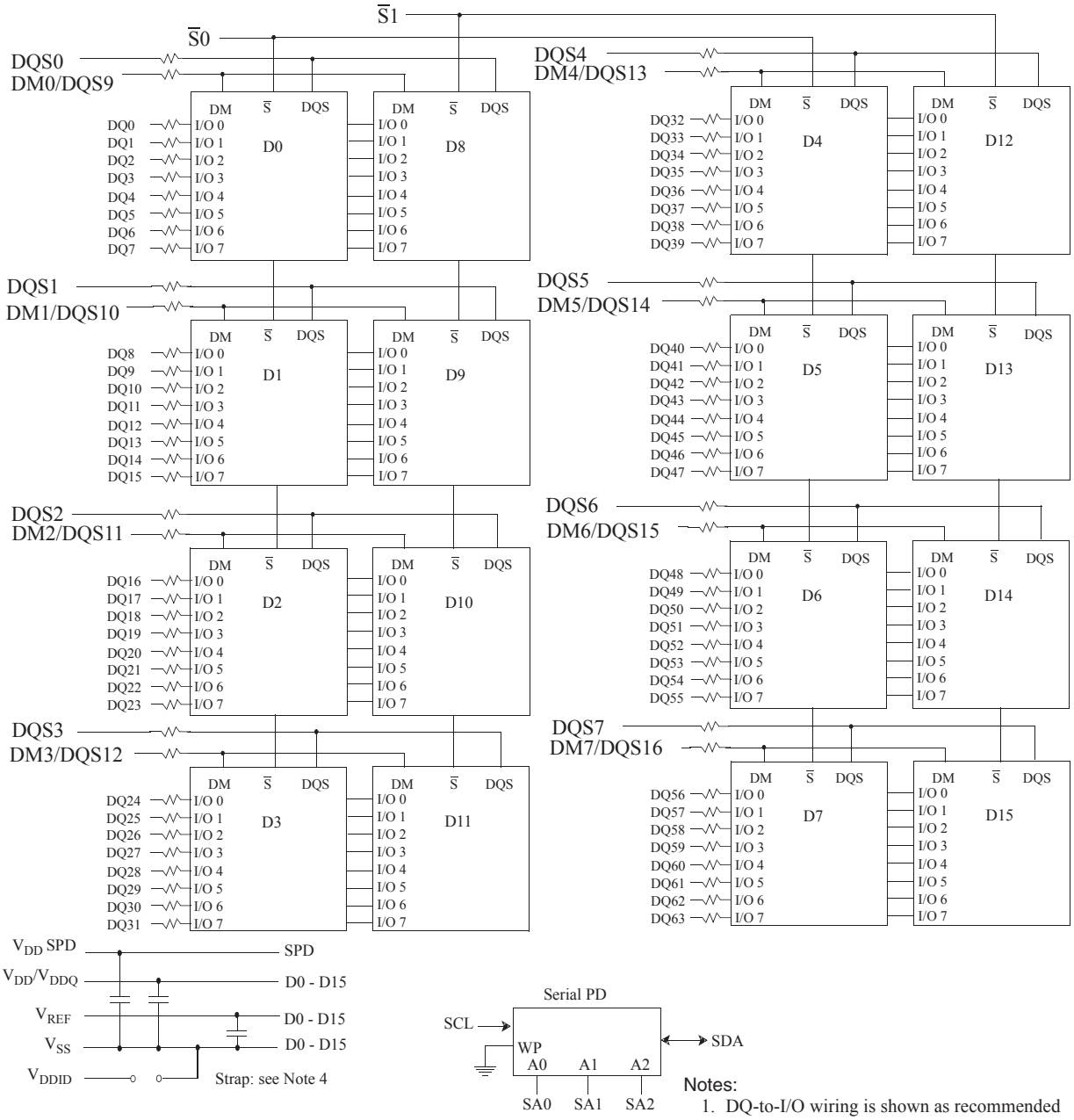
- **１８４ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール**
  （ピン・ピッチ 1.27mm）
- **基板高 １.２５”（３１．７５mm）**
- **ＣＬ－ｔＲＣＤ－ｔＲＰ=3－3－3（ＰＣ３２００）、2.5－3－3（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００）**
- **２．６Ｖ±０．１Ｖ単一電源（ＰＣ３２００）、２．５Ｖ±０．２Ｖ（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００）**
- **８，１９２リフレッシュ／６４ｍｓ**
- **ＳＳＴＬ＿２コンパチブル**
- **/ＣＡＳレイテンシー３.０，２.５，２.０クロックプログラマブル（ＰＣ３２００）**
- **〃　　２.５，２.０クロックプログラマブル（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００）**
- **２バンク構成**
- **アンバッファードタイプ**
- **シリアルＰＤ**
- **接続端子：電解金メッキ（ｔ≧０．７６μm）**

Outline Drawing



Note: All dimensions are typical unless otherwise stated $\frac{\text{millimeters}}{\text{inches}}$

Functional Block Diagram



* Clock Wiring	
Clock Input	SDRAMs
*CK0/CK0	4 SDRAMs
*CK1/CK1	6 SDRAMs
*CK2/CK2	6 SDRAMs

* Wire per Clock Loading Table/Wiring Diagrams

Notes:

1. DQ-to-I/O wiring is shown as recommended but may be changed.
2. DQ/DQS/DM/CKE/S relationships must be maintained as shown.
3. DQ, DQS, DM/DQS resistors: 22 ohms ± 5%.
4. V_{DDID} strap connections
   (for memory device V_{DD}, V_{DDQ}):
   STRAP OUT (OPEN): $V_{DD} = V_{DDQ}$
   STRAP IN (V_{SS}): $V_{DD} \neq V_{DDQ}$
5. BAx, Ax, RAS, CAS, WE resistors: 3 ohms ±5%
   (Except PC2100)